
	<h2 style="color: red;">SI1413EDH-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI1413EDH-T1-GE3</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 2.3A SC-70-6</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI1413EDH-T1-GE3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 27678 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI1413EDH-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 2.3A SC-70-6
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	27678 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 2.3A (Ta) 1W (Ta) Surface Mount SC-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	115 mOhm @ 2.9A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 100µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1413EDH-T1-GE3CT

SI1413EDH-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1413EDH-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1413EDH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1413EDH-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI1413DH-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 2.3A SC-70-6</p>	 <p><b>SI1414DH-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 4A SOT-363</p>	 <p><b>SI1413EDH</b> VISHAY SI1413EDH VISHAY</p>	 <p><b>SI1416EDH-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 3.9A SOT-363</p>
 <p><b>SI1413EDH-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 2.3A SC70-6</p>	 <p><b>SI1416EDH-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 3.9A SOT-363</p>	 <p><b>SI1413EDH-T1</b> VISHAY SI1413EDH-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI1414DH-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4A SOT-363</p>

### heiße Teile

Mehr

⊛ SI1405BDH-T1-GE3	↔ SI1405BDH-T1-GE3	⇒ SI1405DL-T1	D SI1405DL-T1-E3	⇒ SI1405DL-T1-E3
↳ SI1406DH	⊛ SI1406DH-T1	D SI1406DH-T1-E3	⇒ SI1406DH-T1-E3	⇒ SI1406DH-T1-GE3
⊛ SI1406DH-T1-GE3	↳ SI1407DL	⊛ SI1407DL-T1	↔ SI1407DL-T1-E3	⇒ SI1407DL-T1-GE3
D SI1410EDH	⊛ SI1410EDH-T1	↳ SI1410EDH-T1-E3	⊛ SI1410EDH-T1-E3	⇒ SI1410EDH-T1-GE3
⇒ SI1413DH-T1	↔ SI1413EDH	⊛ SI1413EDH-T1	↳ SI1413EDH-T1-E3	⇒ SI1413EDH-T1-E3
↔ SI1413EDH-T1-GE3	⇒ SI1414DH-T1-GE3	D SI1414DH-T1-GE3	⊛ SI1416EDH-T1-GE3	↳ SI1416EDH-T1-GE3
⊛ SI1417DH-T1-E3	D SI1417DH-T1-GE3	⇒ SI1417EDH-T1	↔ SI1417EDH-T1-E3	⇒ SI1417EDH-T1-E3
↳ SI1417EDH-T1-GE3	⊛ SI1417EDH-T1-GE3	↔ SI1422DH-T1-GE3	⇒ SI1422DH-T1-GE3	⇒ SI1424EDH-T1-GE3
⊛ SI1424EDH-T1-GE3	↳ SI1426DH-T1-E3	⊛ SI1426DH-T1-E3	D SI1426DH-T1-GE3	⇒ SI1426DH-T1-GE3
↔ SI1427EDH-T1-GE3	⊛ SI1427EDH-T1-GE3	↳ SI1428EDH-T1-GE3	⊛ SI1428EDH-T1-GE3	⇒ SI1433DH-T1

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited